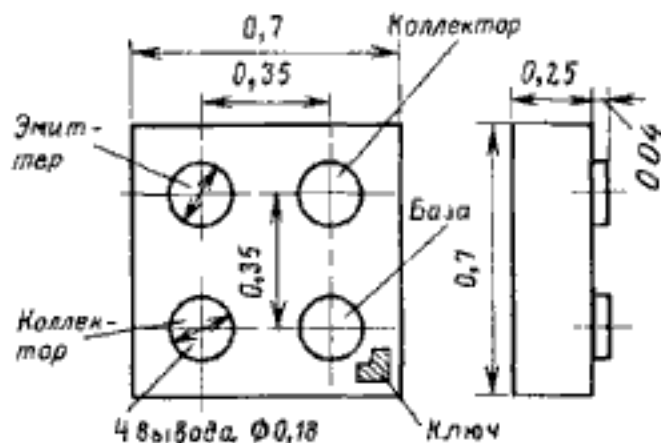


КТ207А, КТ207Б, КТ207В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* мало-
мощные

Предназначены для работы в качестве усилительного эле-



мента микромодулей и блоков в герметизированной аппаратуре
Бескорпусные, без кристаллодержателя, с защитным покрытием и
контактными площадками для присоединения в электрическую схему
Обозначение типа приводится на групповой таре.

Масса транзистора не более 0,001 г

Электрические параметры

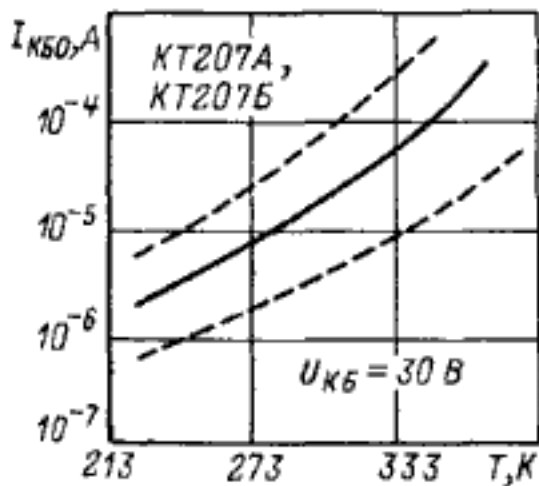
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 1$ мА не менее	5 МГц
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 1$ мА, $f = 1$ кГц.	
КТ207А не менее	9
КТ207Б	30–150
КТ207В	30–200
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более	
КТ207А, КТ207Б	1 В
КТ207В	0,5 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f = 10$ кГц не более	10 пФ
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 1$ мА не более	300 Ом
Обратный ток коллектора не более:	
при $U_{КБ} = 60$ В КТ207А	0,05 мкА
при $U_{КБ} = 30$ В КТ207Б	0,05 мкА
при $U_{КБ} = 15$ В КТ207В	0,05 мкА
Обратный ток эмиттера не более.	
при $U_{ЭБ} = 30$ В КТ207А	1 мкА
при $U_{ЭБ} = 15$ В КТ207Б	1 мкА
при $U_{ЭБ} = 10$ В КТ207В	1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

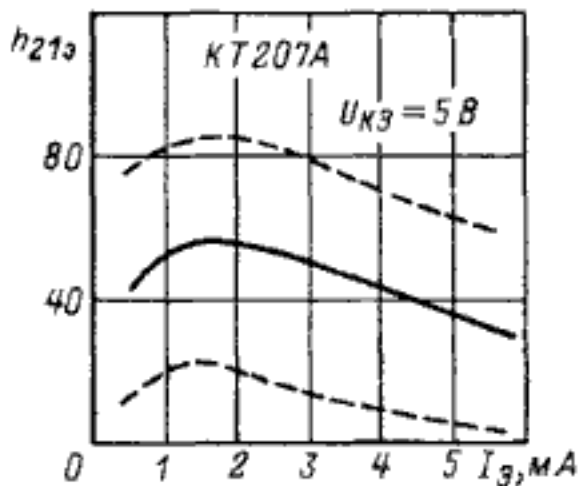
Постоянное напряжение коллектор-база:		
КТ207А		60 В
КТ207Б		30 В
КТ207В		15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:		
КТ207А		60 В
КТ207Б		30 В
КТ207В		15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база:		
КТ207А		30 В
КТ207Б		15 В
КТ207В		10 В
Постоянный ток коллектора		10 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 100$ мкс, $Q \geq$		
≥ 5		50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора		15 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при		
$\tau_n \leq 100$ мкс, $Q \geq 5$		50 мВт
Температура перехода		373 К
Температура окружающей среды		От 228
		до 358 К

Примечание. При эксплуатации транзисторов должен быть обеспечен надежный теплоотвод от кристалла не хуже, чем теплоотвод в свободном воздухе. При монтаже и эксплуатации транзисторов необходимо принимать меры защиты от статического электричества.

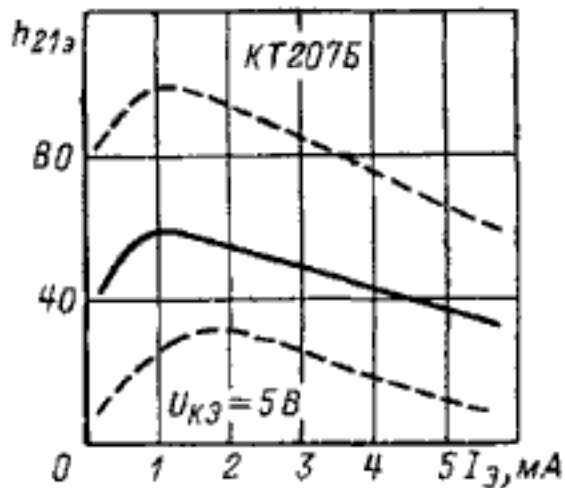
Монтаж кристаллов в микросхемах должен осуществляться в условиях микроклимата или кондиционированных помещениях с относительной влажностью не более 65 % и температурой $(298 \pm \pm 10)$ К.



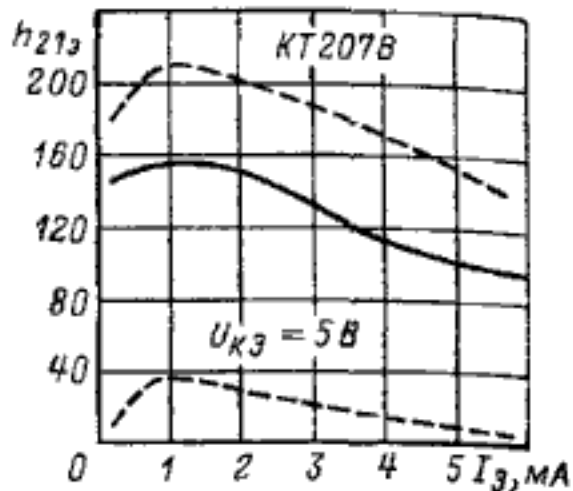
Зона возможных положений зависимости обратного тока коллектора от температуры.



Зона возможных положений зависимости коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от тока эмиттера.



Зона возможных положений зависимости коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от тока эмиттера.



Зона возможных положений зависимости коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от тока эмиттера.